

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт сильноточной электроники  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

21.08.2020 № 10-обр.

г. Томск

О зачислении в аспирантуру  
и назначении стипендии аспирантам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233, Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденными приказом директора института от 10 мая 2017 г. № 7-обр., и на основании протокола заседания приемной комиссии № 1 от 21 августа 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Собынина Романа Константиновича с 24 августа 2020 года зачислить в порядке перевода из аспирантуры ТУСУР на второй курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета сроком на 3 года по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи по направленности (специальности) 05.27.02 – вакуумная и плазменная электроника, и установить Собынину Р.К. с 01 сентября 2020 года по 31 января 2021 года ежемесячную стипендию в размере 10471,48 рублей.

Директор института  
академик РАН

*Н. А. Ратахин*

Н. А. Ратахин

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель ООД  
Начальник ПЭО

*И. В. Пегель*  
*Н. В. Логинова*

И. В. Пегель  
Н. В. Логинова